

高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关

主要特点

- 集成 700V 高压 MOSFET 和高压启动电路
- 集成整流桥和续流二极管
- 多模式控制、无异音工作
- 支持反激、降压和升降压拓扑
- 支持超低压输入 (>20V)
- 空载功耗低于 100mW
- 支持最高 30kHz 开关频率
- 良好的线性调整率和负载调整率
- 集成软启动电路
- 内部保护功能:
 - 过载保护 (OLP)
 - 逐周期电流限制 (OCP)
 - 异常过流保护 (AOCP)
 - 输出过压保护 (OVP)
 - 过温保护 (OTP)
- 封装类型 ASOP-7

产品描述

KP301 是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关, 适用于离线式小功率降压型应用场合, 外围电路简 单、器件个数少。同时产品内置高耐压 MOSFET 可提高系统浪涌耐受能力。

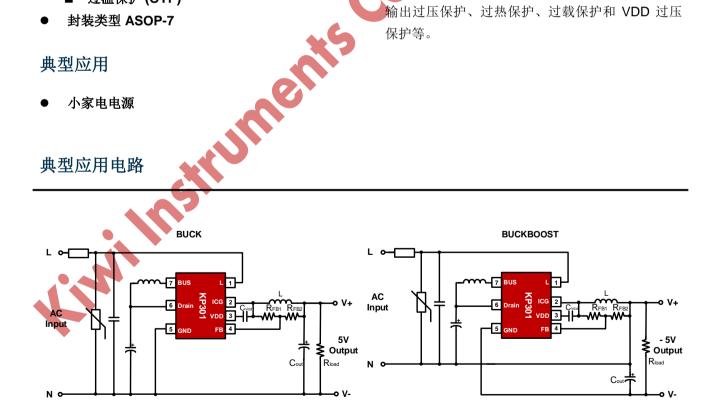
与传统的 PWM 控制器不同,KP301 内部无固定时 钟驱动 MOSFET,系统开关频率随负载变化可实 现自动调节。同时芯片采用了多模式 PWM 控制技 术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和 负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外, 芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自 动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。

KP301 集成有完备的带自恢复功能的保护功能: VDD 欠压保护、逐周期电流限制、异常过流保护、 输出过压保护、过热保护、过载保护和 VDD 过压 保护等。

典型应用

小家电电源

典型应用电路



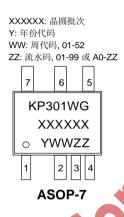


管脚封装



ASOP-7

产品标记



典型功率表(1)

产品	封装	内阻	输出电压	输出电流@85-265Vac,BUCK@85℃ ⁽²⁾
KP301	ASOP-7	20Ω	>2V	lo<250mA

- (1) 默认降压型输出。
- (2) 实际输出功率取决于输出电压和散热条件

管脚功能描述

管脚	名称	I/O ⁽³⁾	描述
1	L	Р	内部整流桥输入端
2	ICG	Р	芯片地
3	VDD	Р	芯片供电管脚
4	FB	I	反馈输入管脚
5	GND	Р	电路地
6	Drain	Р	内部高压 MOSFET 的漏极
7	BUS	Р	内部整流桥输出正端

www.kiwiinst.com

(3) I-输入; O-输出; P-功率; G-地

代理商: 深圳市尚达微电子有限公司 邮箱: sales1@sdwmet.com

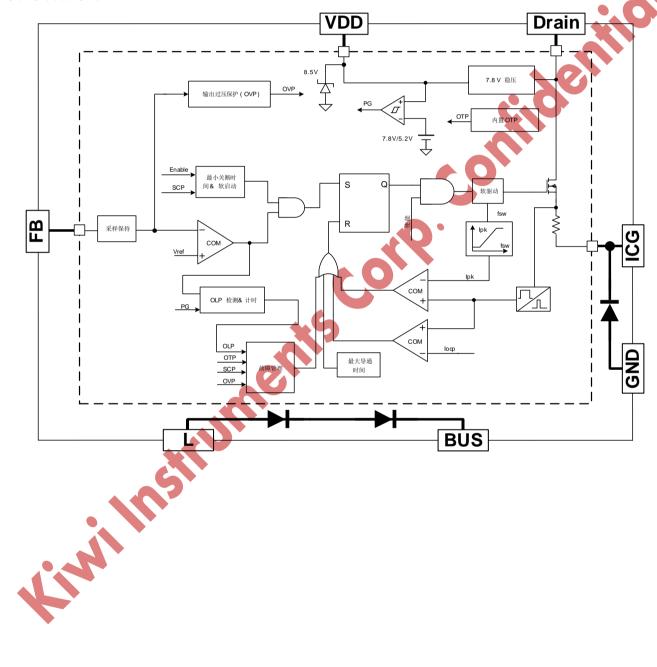


订购信息

订购型号(4)	描述		
KP301WGA	ASOP-7,无卤、编带盘装,5000 颗/卷		

(4) 订购型号末位为"A"表示产品以编带包装方式出货。

内部功能框图





极限参数(5)

参数	数值	单位
Drain - ICG 耐压	-0.3 ~ 700	V
BUS – L 耐压	-1.2 ~ 1600	V
ICG – GND 耐压	-0.6 ~ 600	V
VDD – ICG 耐压	-0.3 ~ 9	V
VDD 钳位电流	10	mA
FB – ICG 耐压 ⁽⁶⁾	-0.3 ~ 9	V
封装热阻结到环境 (ASOP-7)	150	C/W
最高芯片工作结温	160	°C
储藏温度	-65 ~ 150	°C
管脚温度 (焊接 10 秒)	260	°C
ESD 能力 (人体模型) ⁽⁷⁾	3000	V
漏极最大直流电流	0.5	А
漏极脉冲电流 (Tpulse=100μs)	2	А

- (5) 超出列表中"极限参数"可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的 情况下,器件可能无法正常工作,所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下, 可能会影响器件的可靠性。
- (6) 在 50µs 脉宽、5mA 脉冲电流范围内, FB 负压极限值为 -1V。
- (7) JEDEC 文件 JEP155 指出,500-V HBM 满足使用标准 ESD 控制流程的安全制造要求。

推荐工作条件

参数	数值	单位
芯片工作结温	-40 ~ 125	°C
满载工作频率	20 ~ 30	kHz

电气参数 (无特殊注明,环境温度为 25℃)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
高压 MOSFET	「部分 (Drain 管脚)					
I _{HV1}	高压供电电流 1	Drain=700V, VDD=0V		0.6		mA
I _{HV2}	高压供电电流 2	Drain=700V, VDD=4V		5		mA
I _{HV_leakage}	高压漏电电流	Drain=700V, VDD=8.5V		9	20	μA
V_{BR}	高压 MOSFET 击穿电压		700			V





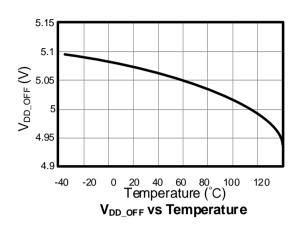
高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关

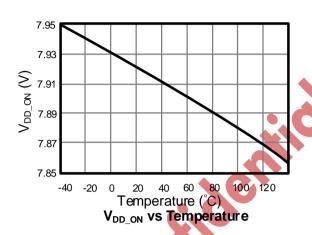
R _{dson}	导通阻抗			20		Ω		
供电部分 (VDI	供电部分 (VDD 管脚)							
V_{DD_ON}	VDD 启动电压		7.6	7.8	8	V		
V _{DD_OFF}	VDD 欠压保护电压			5.1		V		
V _{CLAMP}	VDD 钳位电压	I _{CLAMP} =2mA		8.5		V		
I _{VDD_Op}	VDD 工作电流	Fsw=30kHz		240	300	μΑ		
I _{VDD_Q}	VDD 静态电流	无开关动作		150	190	μA		
反馈部分 (FB	管脚)							
V _{FB_REF}	内部差分放大器输入端基准		1.75	1.78	1.81	V		
V _{FB_OVP}	输出过压保护 (OVP) 检测阈值			2.2		V		
N _{FB_OVP}	输出过压保护 (OVP) 检测延迟 开关周期			3				
V _{FB_OLP}	输出过载保护 (OLP) 检测阈值		\ 0	1.66		V		
$T_{D_{OLP}}$	过载保护延迟时间		5	150		ms		
电流检测输入	部分	.0.						
T _{LEB}	前沿消隐			380		ns		
T _{D_OCP}	过流比较器延时	10.		50		ns		
locp	逐周期过流保护阈值			400		mA		
IAOCP /IOCP	AOCP 与 OCP 比例			1.33				
振荡器部分								
Toff_min_norm	典型最短关断时间	稳态工作条件下	27	30	33	μs		
Toff_max nom	典型最长关断时间			2		ms		
T _{OFF_max_FDR}	动态响应模式下最长关断时间			420		μs		
T _{ON_max}	最长导通时间		26	37	48	μs		
Tss	内部软启动时间			3		ms		
T _{Auto_Recovery}	自动恢复延迟时间			500		ms		
过热保护部分								
T _{SD}	过热保护阈值(8)			155		°C		
续流二极管 (IC	CG-GND)							
Vf	二极管正向压降	ES1J		0.4		V		

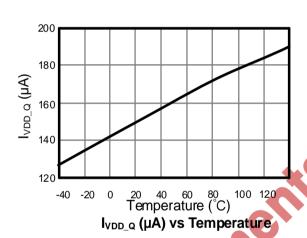
⁽⁸⁾ 参数取决于实际设计,在批量生产时进行功能性测试。

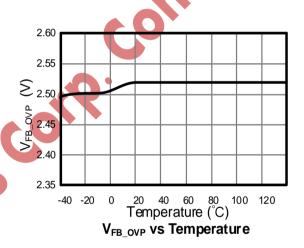


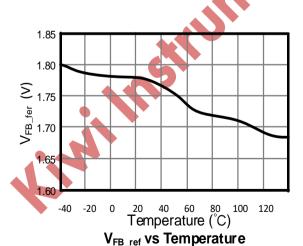
参数特性曲线











代理商: 深圳市尚达微电子有限公司 邮箱: sales1@sdwmet.com



功能描述

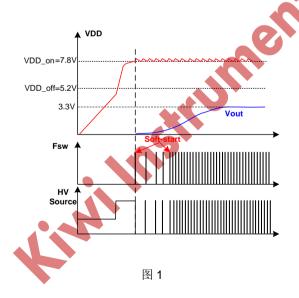
KP301 是一款集成高压 MOSFET 的多模式 PWM 控制功率开关。该系列产品支持非隔离降压和升降 压型拓扑电路,适用于智能模块供电和线性电源替代等场所。同时,KP301 具有输出精度高和外围成本低的特点。

● 超低静态工作电流

KP301 的静态工作电流典型值为 150μA。如此低的工作电流降低了对于 VDD 电容大小的要求,同时也可以降低系统待机功耗。

● 高压启动电路

KP301 内置有一个 700V 高压启动单元。在开机过程中该启动单元开始工作,从 Drain 端取电并通过高压电流源对 VDD 电容进行充电,如"功能模块"中所述。当 VDD 电压上升至 V_{DD_ON} (典型 7.8V) 时,芯片开始工作且芯片工作电流增加至约 240μA。在稳态工作时,芯片通过高压供电电路的开通和关断维持 VDD 电压稳定。



● 输出恒压控制

KP301 通过在每个开关周期里主功率开关关断后对 FB 管脚电压的采样,获得输出电压信息,再利用

内部采样保持电路和恒压控制环路保证续流阶段的 FB 平台电压与内部高精度基准 V_{FB_REF} (典型值 1.78V) 相等。

所以输出电压可近似为:

$$Vo = 1.78V * \frac{Rup + Rdown}{Rdown} - V_F$$

其中:

VF---续流二极管导通电压,实际工作中该参数受证 向电流大小存在一定偏移。

● 逐周期峰值电流限制和前沿消隐

KP301 内置的峰值电流检测阈值具有随系统工作频率变化而变化的特点。当内部峰值电流采样电路采样到的电压超过该阈值时,功率 MOSFET 立即关断直至下一开关周期开始。同时芯片内置有前沿消隐电路 (消隐时间约 380ns),消隐期间内部的逐周期峰值电流比较器将被屏蔽而不能关闭 MOSFET。

● 多模式 PWM 控制

为满足系统平均效率和空载待机方面的严格要求, KP301 采用了调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合的工作模式,如图 2 所示。

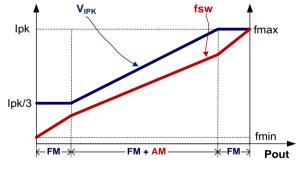


图 2



● 软启动

KP301 内集成有 3ms (典型值) 的软启动电路,在 芯片启动过程中系统开关频率逐渐增加 (Toff 由 100μs 逐渐减小到 30μs),而且每次系统的重新启动都会伴随着一次软启动过程。

● 输出过压保护 (OVP)

当在连续的 3 个工作周期里 KP301 检测到 FB 脚电压高于 2.2V 以上时,芯片将进入输出电压过压保护 (OVP),随后系统将进入自动重启模式。

● 过载保护 (OLP) / 短路保护 (SLP)

当过流或短路情况发生时,输出电压和反馈电压将降低且低于输出过载保护阈值 VFB_OLP。如果在150ms (典型值) 的时间内该状态持续存在,则芯片将停止开关动作并进入自动重启模式 (如下描述)。

● 异常过流保护 (AOCP)

在某些情况下 (如重载或者输出短路等),系统的电感电流峰值将上升过于剧烈。为避免电感峰值电流过大对系统元器件造成损坏,芯片内部设计有异常过流检测模块 (AOCP,典型阈值为 1.33*OCP)。当内部采样电压高于该阈值时,内部功率 MOSFET即刻关断并保持关断状态持续 60μs。

● 过热保护 (OTP)

KP301 内部集成的过热保护电路会检测芯片的内部结温,当芯片结温超过155度(典型值)时,系统进入到自动重启模式。

• 优化的动态响应

KP301 集成有快速动态响应功能,可降低负载切换时的输出电压跌落。

● 消除可闻噪音

KP301 通过采用频率调制和 CS 峰值电压调制调相 结合的多模式控制方式,可实现在全负载范围内有效消除可闻噪音。

● 自动重启保护

芯片触发保护后功率 MOSFET 将关断,同时系统进入自动重启模式,芯片内部的计时器开始工作。当计时器计时超过 500ms 时,芯片将重置并重新开机。开机后若再次触发保护,则系统将再次进入自动重启模式。

• 软驱动电路

KP301 内置有软驱动电路优化了系统 EMI 性能。

应用指南

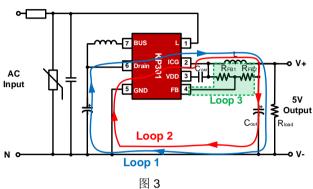
PCB Layout 指导

应用设计上的良好布局有助于 KP301 系统工作稳定,提升 EMC 效果以及散热能力。为获得系统的高性能和可靠性,以下给出的 Layout 指导建议,请结合实际情况加以注意:

- 1. 主功率环路 (Loop1&2): 尽量缩减主功率回路 的走路面积,同时线宽应尽可能粗以优化效率;
- 2. 反馈回路 (Loop3): a) 尽量将该反馈环路置于 主功率回路以外,同时尽可能缩减该环路走线 面积,以减轻主功率回路对其的干扰影响; b) 芯片 FB 引脚走线切勿过长,切勿从 IC 底部进 行引线,否则可能导致系统工作异常; c) FB 检测电路 (FB 分压电阻) 尽量靠近芯片,同时 尽量远离功率电感; d) 建议将反馈环路输出电 压取样点放在输出电容正端,同时注意该条走 线切勿穿越电感或续流二极管底部,以免耦合 高频杂波干扰系统正常工作; e) 确保反馈回路 地与芯片地等信号地线首先连接,之后再与电 感地等功率地单点连接;
- 3. 供电回路: VDD 电容应紧贴芯片,保证的 VDD 供电回路面积尽可能小:



4. 其他注意事项: a) 在整流桥后添加 π 型滤波电 路的情况下,应确保功率电感远离滤波电感, 以免发生此耦合对 EMC 不利; b) PCB 面积允 许情况下,适当增加 IC Drain 端的铜箔面积, 有助于 KP301 更好散热。



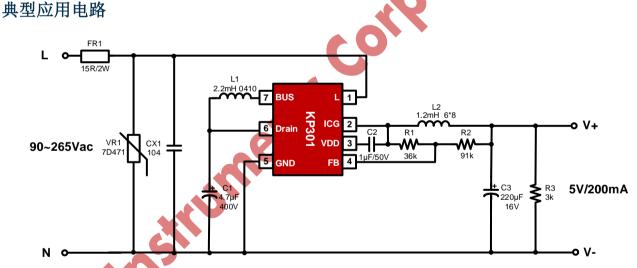
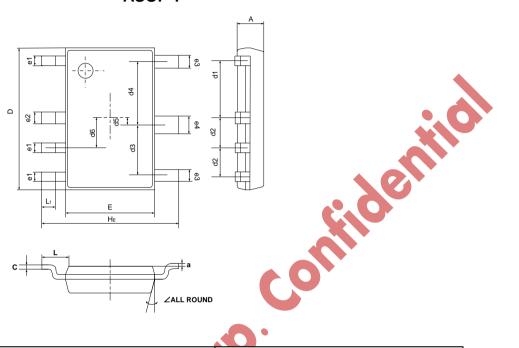


图 4 典型应用电路图



封装尺寸

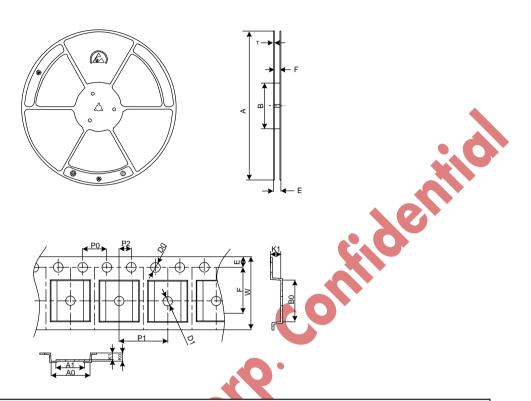
ASOP-7



符号	尺寸((毫米)	尺寸 (英寸)		
17 5	最小	最大	最小	最大	
Α	1.050	1.250	0.041	0.049	
а	0.200	(REF)	0.008	(REF)	
С	0.150	0.220	0.006	0.009	
D	6.100	6.300	0.240	0.248	
d1	2.410	2.610	0.095	0.103	
d2	1.230	1.430	0.048	0.056	
d3	2.080	2.280	0.082	0.090	
d4	2.580	2.780	0.102	0.109	
d5	0.2	250	0.010		
d6	1.2	280	0.050		
E	3.800	4.000	0.150	0.157	
e1	0.300	0.500	0.012	0.020	
e2	0.410	0.610	0.016	0.024	
e3	0.450	0.650	0.018	0.026	
e4	0.700	0.900	0.028	0.035	
HE	5.900	6.100	0.232	0.240	
L	0.950	1.150	0.037	0.045	
L1	0.500	1.000	0.020	0.039	
	12°				



编带和卷盘信息



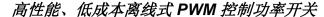
卷盘尺寸 (mm)						
Α	B (内径)	E	F	Т		
330±2	100±1	16.9±0.5	12.7 ⁺² _{-0.5}	2.1±0.2		

编带尺寸						
符号	尺寸 (mm)	符号	尺寸 (mm)			
A0	6.40±0.10	K1	1.50±0.10			
В0	6.60±0.10	Е	1.75±0.10			
K0	1.70±0.10	F	5.50±0.05			
P0	4.00±0.10	D0	1.55±0.05			
P1	8.00±0.10	D1	1.55±0.05			
P2	2.00±0.05	W	12.0±0.30			
A1	3.80±0.10					

包装数量						
封装形式	只/盘	盘/盒	盒/箱	只/箱		
ASOP-7	5000	2	5	50000		

代理商: 深圳市尚达微电子有限公司 邮箱: sales1@sdwmet.com







声明

必易微保留在没有通知的情况下对其产品和产品说明书或规格书进行任何修改的权利。客户下单前请获取最新资料。 产品说明书或规格书不用于作任何明示或暗示的保证包括但不限于产品的商用性、目的适用性或不侵犯他人权利等, 也不用于作任何授权包括但不限于对必易微或第三方知识产权的授权。使用者在将必易微的产品整合到应用中时或使

A path coil in the coil is a path coil in the coil in